# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63294925 A

(43) Date of publication of application: 01.12.88

(51) Int. Cl B01D 53/22

(21) Application number: 62128480

(22) Date of filing: 27.05.87

(71) Applicant: ISE

ISE KAGAKU KOGYO KK

(72) Inventor: KIKUCHI HIDEKAZU

# (54) FILM FOR SEPARATING HYDROGEN AND PRODUCTION THEREOF

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an  $\rm H_2$  permeable film causing no cracking by successively forming a thin Pd film and a thin Cu film by chemical plating on the surface of a heat resistant porous body and heat treating the films.

CONSTITUTION: A thin Pd film and a thin Cu film are

successively formed by chemical plating on the surface of a heat resistant porous body such as a sintered body of fine ceramic particles or porous glass. The formed films are heat treated at about 300W540°C to diffuse Pd and Cu and to form a thin Pd-Cu alloy film. The resulting film has  $\rm H_2$  permeability and does not cause cracking.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### 母公開特許公報(A) 昭63-294925

Dint Ci.

庁内整理番号 織別記号

母公開 昭和63年(1988)12月1日

B 01 D 53/22

G-7824-4D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

**公発明の名称** 水素分離用膜及び水素分離用膜の製造法

> ②特 顧 昭62-128480

❷出 願 昭62(1987)5月27日

②発 明 者 英一 菊 地

東京都世田谷区船橋1丁目45番12号

⑪出 願 人 伊勢化学工業株式会社 東京都中央区八重洲2丁目7番12号

外1名 70代 理 人 弁理士 栂村 繁郎

### 1、発明の名称

水素分離用膜及び水素分離用膜の製造法 2. 特許請求の範囲

- (1) Pd及び Cuを主体とする合金存款よりなるこ とを特徴とする水素分離用膜。
- (2) 合金確膜はPdを71~94 wt%. Cuを6~ 2 9 wt%合むことを特徴とする特許請求の範囲的 1 項記載の水素分離用膜。
- (3)多数の小孔を有する耐熱性多孔体の表面に Pd薄膜を、Pd薄膜上にCu糠膜を夫々化学メッキ法 によって形成させ、次いで加熱処理を行なうこと を特徴とする水素分離用膜の製造法。
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

木発明は水楽分離用膜及び水素分離用膜の製造 法に関するものである.

(従来の技術)

Pdを主体とする水素分離用膜は広く知られてい

本発明者は多数の小孔を有する耐熱性多孔質体 の表面にPdを主体とする膜を化学メッキ法によっ て形成させることをにより性能の極めて良好な水 素分離用膜の得られることを見出し、 特顧昭 6 1 ·-113576号(先願発明という)として特許 出願した。

# (発明が解決しようとする問題点)

Pdを主体とする蘇騰は水素の透過選択性及び水 素の透過速度が大きく、水素分離用度として舒適 なものであるが300℃以下の低温ではPdの水素 化合物形成によりひび割れ等が生じ易い問題点を 有する.

木発明は従来技術が有していた上記問題点を解 前することを目的とするものである。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

本発明は前述の問題点を解決すべくなされたも のであり、Pd及びCuを主体とする合金確談よりな ることを特徴とする水素分離用膜及び多数の小孔を有する耐熱性多孔体の衰弱にPd篩膜を、Pd篩膜 上にCu 膜を失々化学メッキ法によって形成させ 次いで加熱処理を行なうことを特徴とする水素分 離用膜の製造法を提供するものである。

次に本顧第1発明(以下単に第1発明という)を更に具体的に説明する。

第1発明においてはPd及びCuを主体とする合金 (以下本合金という) 等膜を水素分離用膜として 使用する。本合金としてはPd7  $1 \sim 8.4$  mt%、 好 ましくは $8.0 \sim 9.2$  mt%、 Cu5  $\sim 2.9$  mt%、 好ま しくは $8 \sim 2.0$  mt%のものが適当である。

Cuの量があまり少ない場合、本発明の効果が充分でなく、又Cuの量があまり多いと水素の透過度 択性、水素の透過速度が低下し易い。

なお本台金中に若干のNi、W、N等の製成分を 含有させることもでき、本合金はこれら製成分を 含有する合金を含むものである。

木合金種膜の製造法に特に限定はないが、Pd、 Cu等の合金成分を所定割合に製合しArのような不 括性雰囲気中で解除して合金となし、 得られた合金を60~100 ¤程度に伸延することによって製造することができる。

このようにして得られた苺取は支持枠で支持して水素分離用に好適に使用でき、300℃以下の低級で使用してもひび割れ等を生ずることはない

次に本願的2発明(以下単に的2発明という) を更に具体的に説明する。

第2発明においては多数の小孔を有する断熱性 多孔質体(以下単に多孔質体と言う)の変質に Pd 確限(以下単にPd膜という)を化学メッキ法によって形成させ、符られたPd膜上に化学メッキ法に よって Cu 障膜(以下単に Cu 膜という)を形成さ せ、次いで加熱処理を行なうことによって Pd、 Cu を拡散させ、Pd、 Cuを主体とする合金(本合金) よりなる水素分離部用膜を形成させる。

第2発明によって得られる水素分離用膜は先願 発明で開示したように多孔質体の小孔を覆って形 成されこの多孔質体で支持されているため、本合

金を伸延する場合に比し遙かに輝く(1 μ程度 迄)した場合でも工業的使用に耐える充分な継載 的強度を有し、ピンホールもなく、水素透過速度 を大とすることができ、しかも高価なPdを使用量 を大幅に節載することができる。

多孔質体としては、300℃以上、鍵ましくは400℃以上の温度に耐える耐熱性を有し、処理すべき気体と反応性を有せず、且つ20~30,000人望ましくは40~5,000人の均一な小孔を有する多孔質体を使用するのが適当である。

多孔質体としては A Q \* 0。 等のセラミック散粒の 焼結体、多孔質硝子が例示されるが、多孔質硝子 を使用するのが好ましい。

多孔質硝子としてはバイコール硝子、或はSiO<sub>2</sub>45~70 wt%、B<sub>2</sub>O<sub>2</sub>8~30 wt%、CaO 8~25 wt%、AQ<sub>2</sub>O<sub>2</sub>5~15 wt%、Na<sub>2</sub>O3~8 %、K<sub>2</sub>O 1~5%、Na<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O 4~13 wt%、 NgO 0~8 wt%なる組成を有する硝子(以下硝子 Aという)又はSiO<sub>2</sub>45~70 wt%、B<sub>2</sub>O<sub>2</sub>8~ 30 wt%、CaO 8~25 wt%、AQ<sub>2</sub>O<sub>2</sub>5~15 %なる組成を有する硝子(以下硝子Bという)を 熱処理して $B_{2}O_{2}$ 、 $C_{4}O$  を主体とする相を分相せし め、この相を溶解除去することによって得られる 多孔質硝子(以下、多孔質硝子A 又は B と呼ぶ) が適当であり、多孔質硝子A を使用することによって特に打造な結果をうることができる。

上述した多孔質体としては 1 ~ 0.2 mmの厚みを 有する円筒状、又は板状のものを使用するのが適 当であり、このような多孔質体は所定形状に成型 した原料硝子に分相処理、溶解処理を施こすこと によって得ることができる。

硝子A、Bを所定形状に成型した接無処理してCaO、BzOsを主体とする相(以下CaO、BzOs相という)を分相せしめる。如無処整温度が高い程、又無処理時間が長い程CaO、BzOs相は大きくなり、従って得られる多孔硝子の小孔の径は大きくななる傾向を有し、無処理条件を選択することができる。このようにして得られた多れ質硝子は、小孔の径は均一であり、木苑明の目

的を達成するのに極めて好遊なものである。

加热処理を行った硝子をHCQ 、  $H_a$ 50、等の酸中に投資して Ca0 、  $B_a0$  a相を溶解除去する。なお瞭処理を行なうに完立ち、HF移根で短時間その表質をエッチング処理するのが望ましい。

無処理の条件によって、得られる多孔硝子の小孔の径を制御することができ、又小孔の径は多孔 質硝子中に残存する B = 0 = の量に応じて変化すること及びこの B = 0 = の量は無処理、酸処理の条件によって左右されることが判明した。そして B = 0 = が望ましく 0.5 \*\* t \*\* 以上残存するようこれらの条件を定めることにより特に纤速な結果の得られることが判明した。

望ましい処理条件は次の通りである。

加熱程度 600 ~850 ℃

加熱時間 2~48hr、望ましくは12~24hr

酸の種類 HCQ、HaSO、HNOs

酸の装皮 0.01~2.0 N、复ましくは0.1~

1.0 N

処理時間 2~20hr、望ましくは4~16hr

密徴による処理を交互に行なう数、一方の複雑の 処理終後、純水による充分な洗浄を行なうのが適 当である。

次いで多孔質体を以下示すようなメッキャに援 強することにより、前述の処理によって形成され た活性化Pd上にPdを析出させ、多孔質体の表面例 明ロ部を取ってPd膜を生成せしめることができ る。この祭マスキング等によって多孔質体の必要 な部分のみにPd膜を形成させるのが適当である。

例えば円筒状の多孔質体の外表面にPd膜を形成 させる場合、円筒の四塊面に閉塞することにより外面のみに $Pd膜を形成させることができる。 或は又<math>[Pd(NH_2)_4]$   $CQ_2$  ・ $H_10$  を主体とするメッキ液を用いる場合、アルコール、水のような液体を滲み込ませておくことにより、小孔内部にはPd膜を形成させることなく、多孔質体表面のみ<math>Pd膜を形成させることができる。

上記手段のうち低級アルコールを用いることは 本発明の目的を達成するのに特に有効である。 [Pd(NH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>] CQ<sub>8</sub> が低級アルコールに寂解性を有 製 度 50~95℃、超ましくは80~90℃ 上述した多孔質体に化学メッキ法によりPd膜を 形成させ 。

化学メッキを施こす前に多孔質体の表面に付着する汚れを飲去するため洗浄を行なうのが望ましい。 行選な汚れ飲去法としては、トリクロロエチレンを用いた超音被洗浄技が例示できる。トリクロエチレンによる洗浄を行ない多孔質体に残存するトリクロロエチレンをアルコールで養装し、次いで洗針るのが適当である。

その後化学メッキに先立ち、多孔質体の活性化を行ない、多孔質体に活性化されたPdを被差するのが適当である。

活性化は例えば、 $SnCQ_a$  溶液及び $PdCQ_a$  溶液による浸渍処理を交互に行なうことによって舒適な結果をうることができる。好ましい処理被の組成として $SnCQ_a$  O(1) O(1)

しないためと思われる。

化学メッキによってPd膜を形成させるために好 適に用いられるメッキ被として次の組成の溶液が 例示される。

[ Pd(NH<sub>2</sub>) 4] CQ<sub>2</sub> ~ H<sub>2</sub>0 5.4 g/を EDTA ~ 2Na 67.2g/を NH<sub>2</sub> (28%水溶液) 851.3 g/を H<sub>2</sub>NNH<sub>2</sub> ~ H<sub>2</sub>O 0.46 m2/2

pH 11.3 ### 50℃

形成させるPd膜の厚みが小さい程水素の返過速度が大となり、且つ高価なPd使用量を減少することができるが、あまりこの厚みを小とするとPd膜にピンホールが生じ水素以外の気体がリークし易くなる。この傾向は、小孔閉口部の径が大きくなる程増大する。

舒適なPd膜の厚さは小孔の径が3,000 人の場合 0.01mm程度である。

メッキ所要時間はPd膜の耳みが大となる程大きくする必要があるが、耳みC.Clamの場合17hr程

度である。

このようにして形成されたPd膜上に化学メッキ 法によってCu棘を形成させる。

なお多孔質体上に化学メッキ法によって Cu膜を形成させ、次いで化学メッキ法によって Pd膜を形成させることも 試みたが、 好適な結果をうること はできなかった。メッキ液としては次の組成の溶液が例示される。

1.5 g/l
28.8 g/1
20 ag/1 A
50 mg/1
12.5
В

担度 60°C

なおAのpHはNaOH紙加により調整する。

メッキ所要時間は耳みが0.0023mmの場合 5 hr程度である。

Pd膜、Cu膜を形成後、好ましくは洗浄真空乾燥後

熱処理を行なうことによりPd、Cuを拡放させ、 Pd、Cuを合む合金よりなる本質を形成させること ができる。

なお処理はAr、或はHzとHzの報合ガスのような不活性又は最元性雰囲気で行なうのが適当である。

Pd酸とCu膜の厚みを所定比に保つことにより所望組成を有する本膜をうることができる。

熱処理によりボラジウムと網とが合金化することはX銀回折法により確認された。第1因にそのX銀回折結果を示す。第1因のa)は多孔贯がラス上にバラジウムをメッキしたもの。b)はバラジウムメッキしたもの。c)はバラジウムメッキをしたもの。c)はでうた時間である。ここでa)、b)によりそれぞれの金

異は良好にメッキしうることが確認できる。また d)によりバラジウムと倒とは無処理により容易 に合金化させることが可能なことがわかる。

なおPdとCuを同時に化学メッキにより折出させることも試みたが、 及紆な結果をうることができなかった。

無処理を行なわない酸(第1図cの酸)は水素の透過性を示さないが、無処理を行ない、Pd. Cuの拡散、合金化が進行するにつれ、水素の透過性は大幅に上昇する。

第2回は3,000 人の平均係を有する多孔質硝子 A上に25hrのメッキで形成させた厚み0.01mmの Pd膜の上に5hrのCuメッキで形成した厚み0.0023 mmのCu膜を使用し、400℃において、Ha、Naの 等モル総合物を使用し圧力差5kg/cmのもとに行 なった水素の透過速度の変化を示すグラフであ

このグラフに示すように初期には約10ml/minの水素透過能を示すにすぎないが、合金化の進行とともに水素透過能は増加し、約15時間後には

一定の透過量となった。さらにこの膜をアルゴン 気流中にて500℃で処理しても、その透過量は 変化しなかった。また透過ガス中の水素モル分率 は、図の黒丸プロットで示したように初期から 100%であった。なお、初期に嵌少の水素透過 がみられるのは、アルゴン気流中で400℃まで 昇弧する際に合金化が一部起こったためと考えら れる。

この酸は長時間使用しても性能は劣化せず、又 300℃以下の低温で使用してもひび割れ等を生 することもない。

# (実施例1)

Pd8 8 wt%、 Cu 1 2 wt% よりなる合金を伸延 し、8 0 μの確膜とした。

この砂膜の200℃、差圧 5 kg/cm における水 素の透過速度は43 m 2 / min であり、長時間使 用しても性能の低下、ひび割れを生ずることはな く、純度100%の水素をうることができた。

# (实施例2)

Si0.49 w t % . 8.0.18 vt% . Ca0 13 vt

X. AQsOs 9 vt X、 NasO 5 vt X、 NsO 2 vt X、 NsO 4 vt X なる組成を有する硝子製の厚みO.5 as. 内径 1 0 as. 長さ500 asの円筒体を7 1 0 でに20 hr加熱してCaO、 8sOsを主体とする相を分相せしめ、2 X HF溶液で3 O ain エッチングし、次いで80 でのHCQ 1 N 溶液中に I 6 hr侵債してCaO、 8sOsを主体とする相を将解除去して小孔径 J,000 人の多孔関体を得た。

**基板表面の活性化は二液型でおこなった。すな** 

わちSnCQa 感受性化処理(SnCQa・2 HaO + 3 7% BCQ 1ml/l) およびPdCQa 括性化処理(PdCQa 0.1 z/2+37% HCQ 0.1 m2/1) である。 波面のバラジウム核をできるだけ密にするため に、各侵債時間を1分として、交互に10回おこな った。(各務額から引きあげた後におのおの充分 な純木による洗券をおこなった。)なお、これらの 処理は外面のみメッキを施す目的のため、上下を メッキ用テープ(スコッチ社製)で目かくしをし て管内部に疲がはいりこまないように工夫した。 表面活性化を行なった多孔質ガラスは、上下の目 かくしをしたテープをはりかえエタノール中に侵 近し、純水で洗浄した後12中に [Pd(NH<sub>s</sub>)<sub>4</sub>] CQ. . HaO 5.4 gr. EDTA - 2Na & 67.2g . NH.OH を350gr、HaN NHa · HaO を0.4ml合有する 50℃のメッキャに25hr長積した。

なお、このメッキ板はメッキ速度をなるべく一 定とするため1時間に1回交換した。

次いで下配のA被、B被を8:1の割合で混合 してなる60℃メッキ液中に5hr接強してCuメッ

# キを行なった。

なおこのメッキ 兼はメッキ返廃をなるべく一定 とするため 1 時間に 1 回交換した。

Cu(NO <sub>2</sub> ) . • JH <sub>2</sub> O	9.8 g/1
EDTA - 2Na	29.8 g/1
(-CsH4N)=	20 mg/1 A
K . [Fe(CN) .] - 3H . 0	50 mg/1
На	12.5
HCHO ( )5% 水溶液)	. В

A 80al + B 10al

整度 60℃

洗滌、乾燥後Ar雰囲気中で、500℃に12hr 加熱し、Pd、Cuを拡散させ、Pd88 vt%、Cu12 vt%よりなる厚み16μの水素分離用膜を得た。 この膜(有効面積75.4cm)の第1実施例と同条件で測定した水素の透過速度は214m2/min であり、300℃以下で長時間使用しても性能の低下、ひび割れを生ずることはなかった。

(発明の効果)

水溶の選択透過性は良好であり300℃以下の

**体製で長時間使用しても性能の劣化、ひび割れを生ずることはく、純度100%の水素をうることができる。** 

# 4. 図面の簡単な説明

第1図はX級回折結果を示すグラフ、第2図は 加熱時間と水素透過量の関係を示すグラフであ る。

> 特許出願人 伊勢化学工機構為会社 代 厘 人 梅 村 繁 解》 名





